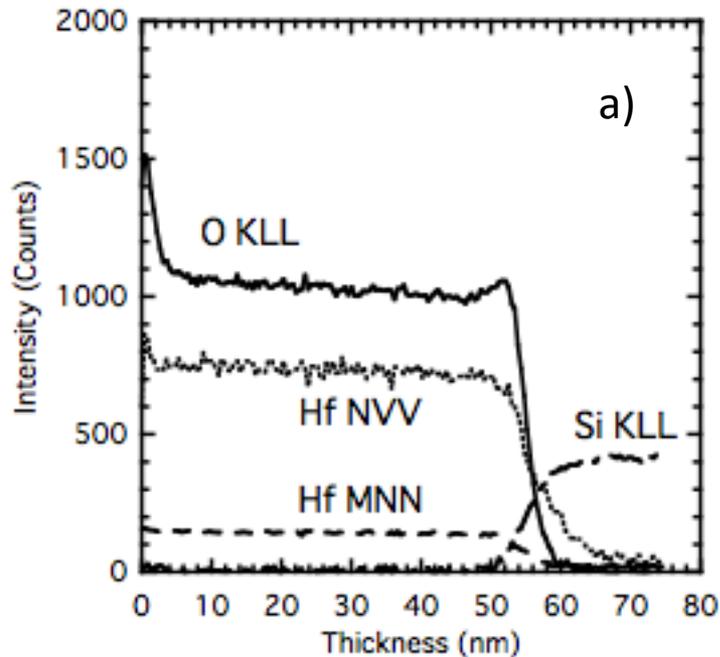


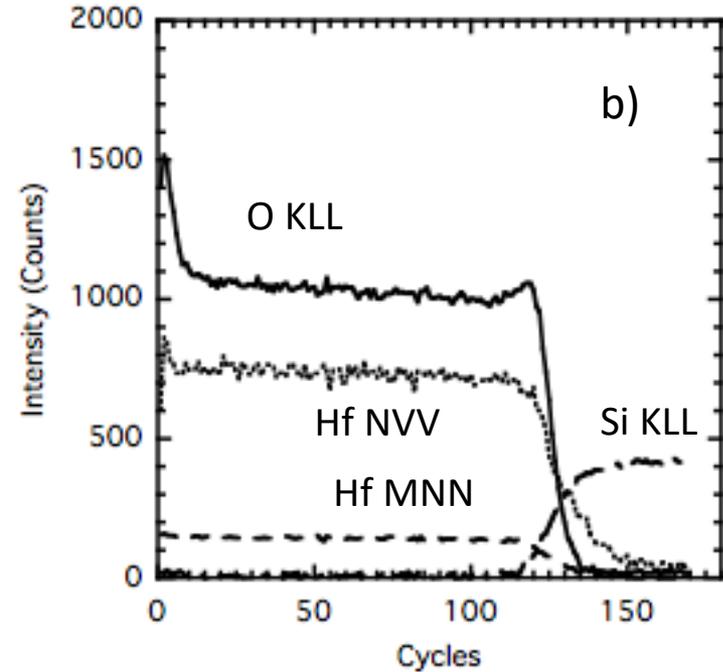
研究論文, ” 極低角度入射ビームオージェ深さ方向分析によるHfO<sub>2</sub>/Si基板の分析” に掲載されている Fig. 11  
オージェデプスプロファイルの Raw data ファイル

DOI <https://doi.org/10.1384/jsa.24.192>

荻原俊弥, 長田貴弘, 吉川英樹, *J. Surf. Anal.* **24**, 192 (2018).



AES depth profiles of the HfO<sub>2</sub>:55 nm/Si substrate using the conventional method with the argon ion energy of 2.0 keV.



AES depth profiles of the HfO<sub>2</sub>:55 nm/Si substrate using the conventional method with the argon ion energy of 2.0 keV.

a) のオージェデプスプロファイルは論文に掲載の Fig.11 に相当し, 横軸は nm である.  
b) は横軸を測定回数で表したものであり, 横軸を nm に変換する前のプロファイルである.  
Raw data ファイルは, b) に対応している.